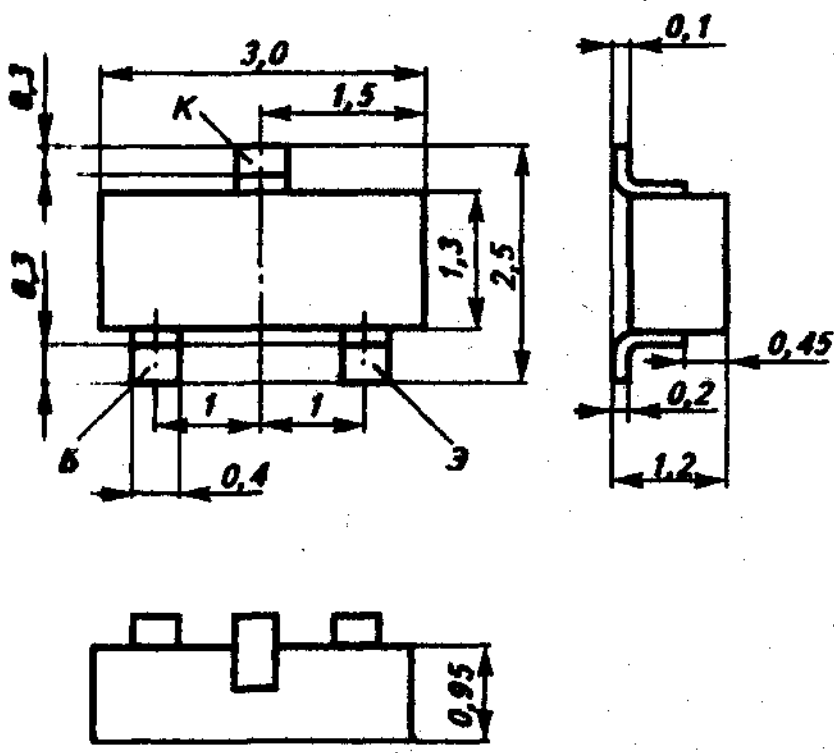


KT3151A9, KT3151B9, KT3151B9, KT3151Г9, KT3151Д9, KT3151E9



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях, генераторах, импульсных устройствах в составе гибридных интегральных микросхем с общей герметизацией. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 0,1 г.

KT3151(A9-E9)

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5 В, I = 10 мА$ для KT3151A9, KT3151B9, KT3151B9, KT3151Г9, $U_{кб} = 1 В, I_э = 0.04 мА$ для KT3151Д9, KT3151E9:

KT3151A9, не менее	20
KT3151B9	30...90
KT3151B9, KT3151Г9	40...120
KT3151Д9, не менее	80
KT3151E9, не менее	40

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5 В, I_э = 1 мА$, не менее: 100 МГц

Граничное напряжение при $I_э = 10 мА$, не менее:

KT3151A9, KT3151B9	80 В
KT3151B9	60 В
KT3151Г9	40 В
KT3151Д9	30 В
KT3151E9	20 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_к = 10 мА, I_б = 1 мА$, не более: 0,6 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_к = 10 мА, I_б = 1 мА$, не более: 1,2 В

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10 В$, не более: 15 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0,5 В$, не более: 20 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{кэ} = 100 В$ для KT3151A9, $U_{кэ} = 90 В$ для KT3151B9, $U_{кэ} = 80 В$ для KT3151B9, $U_{кэ} = 60 В$ для KT3151Г9, $U_{кэ} = 30 В$ для KT3151Д9, KT3151E9, $R_{бэ} = 10 кОм$, не более: 1 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5 В$, не более: 10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 10 кОм$:

KT3151A9, KT3151B9	80 В
KT3151B9	60 В
KT3151Г9	40 В
KT3151Д9	30 В
KT3151E9	20 В

Постоянное напряжение база-эмиттер: 5 В

Постоянный ток коллектора: 100 мА

Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 10 мс, Q = 100$: 150 мА

Постоянный ток базы: 30 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T = -60...+25^{\circ}C$: 200 мВт

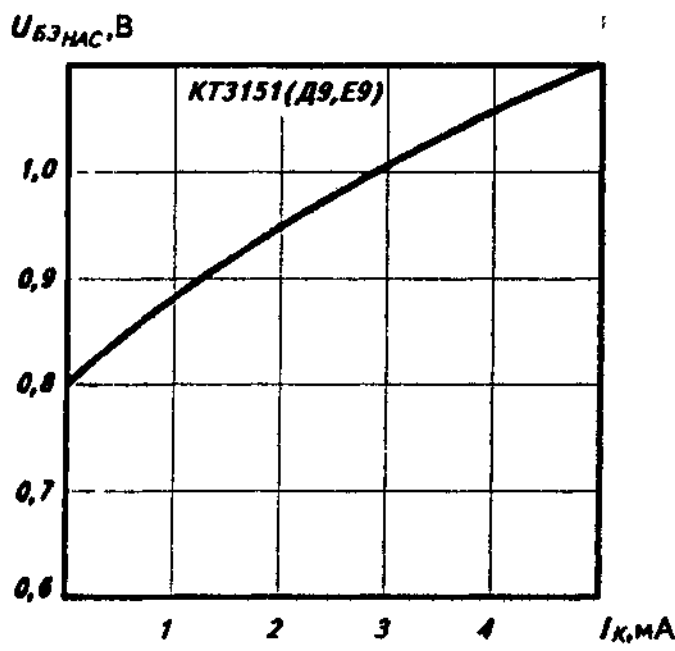
Температура *p-n* перехода: +125°C

Температура окружающей среды: -60...+85°C

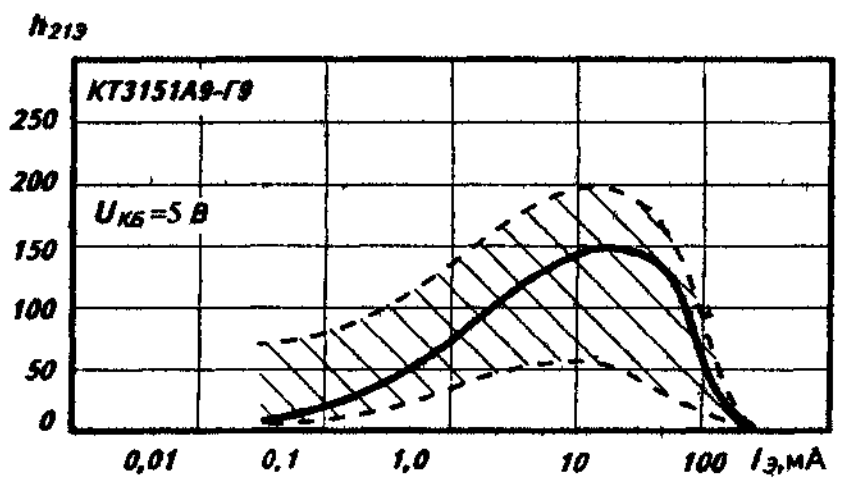
¹При $T > +25^{\circ}C$ максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{к макс} = (125 - T) / 0,5, \text{ мВт}$$

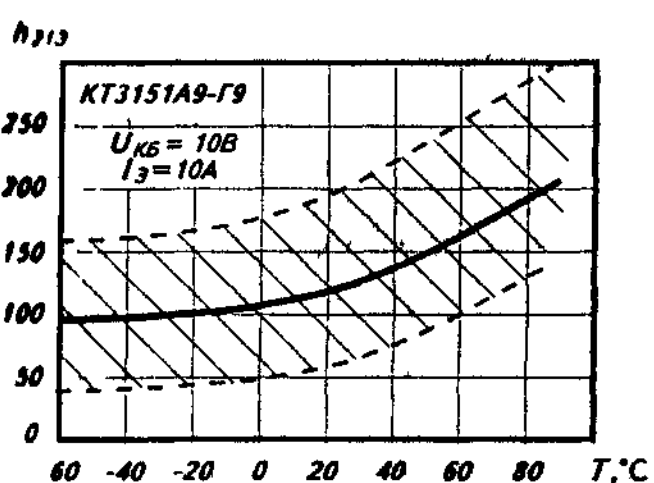
Пайку выводов рекомендуется проводить с применением лудящих паст и припоев расстоянии не менее 0,15 мм от корпуса транзистора, время пайки не более 4 с, температура пайки не более +265°C.



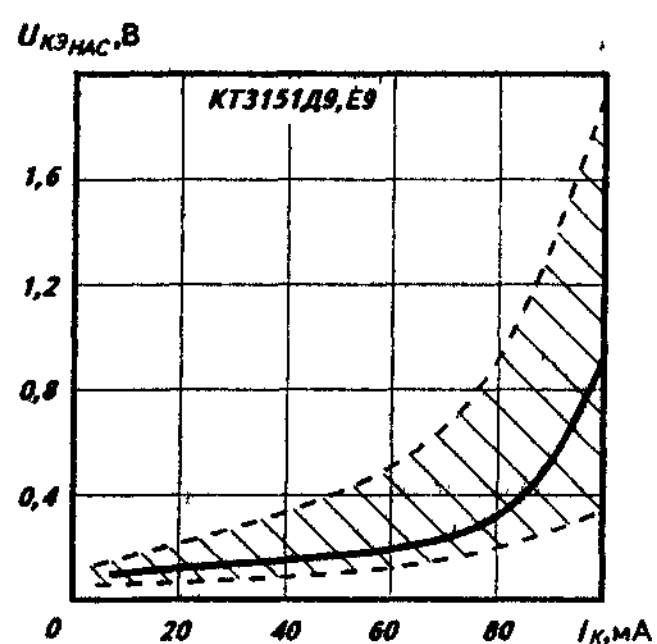
Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора